

(19)
(12)

(KR)
(B1)

(51) 。 Int. Cl. ⁷
G02F 1/136

(45)
(11)
(24)

2002 12 26
10 - 0366082
2002 12 11

(21) 10 - 2000 - 0022760
(22) 2000 04 28

(65) 2001 - 0098097
(43) 2001 11 08

(73) 575

(72) 333 - 3

965 - 10

(74)
:

(54)

: (In - Plane Switching) LDD

:

: LDD

, LDD

1

2

3

**

**

100 : 120 :

140 : (bath) 160 :

180 :

(In - Plane Switching)

LDD

(Active Matrix Liquid Crystal Display)

/ 가 /

가 가 가 가 가

가 가 가 (off set) LDD(lightly doped drain) 가

가 , LDD 가 가 , LDD 가 가
LDD LDD LDD

3 3

(12) (10) (10) (12) ,
(bath, 14) , (16)
가 (18) (18)

(18) (1) (16)

(16) Cr, Ni, Ag, Au, Zn, Sn, Cu, Fe, Al, Pt, V

1 2

가 , 가
LDD

LDD

;

(bath) ; ;

1 (120) , (120) (160) (bath, 140) , (100) 가 (100) (180)

2 (180) (100) (100) (anode) , (160) (160)

(160) (100) (160) (120) 가 (120) (100) (160) (160)

(100) (100) (120) 가 (100) (100) (160) (160)

0) (100) (120) 가 (100) (160) (160) (120) Bu₄NPF₆, Bu₄NClO₄, HCl, H₂SO₄, HNO₃, HCl

O₄ 1 가 (MMA), 가 가 (100) (100) LDD

LDD

가

가

(57)

1.

;

(bath) ,

;

;

2.

1

3.

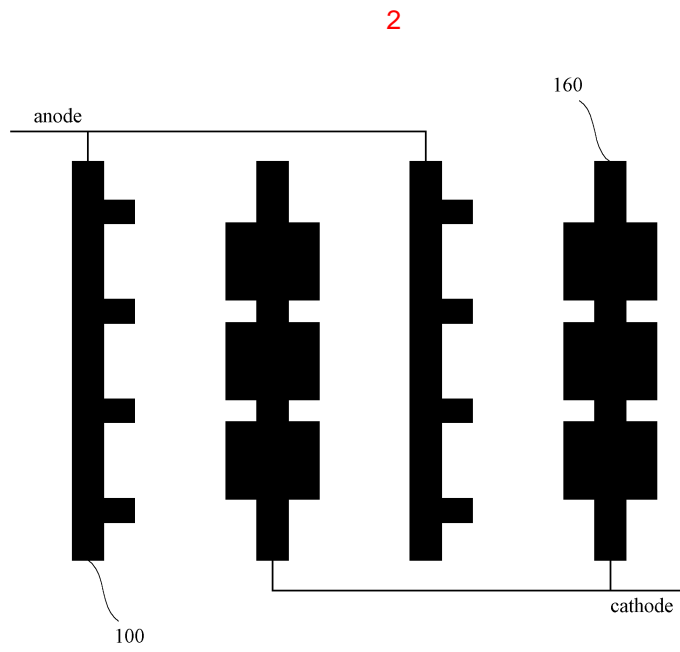
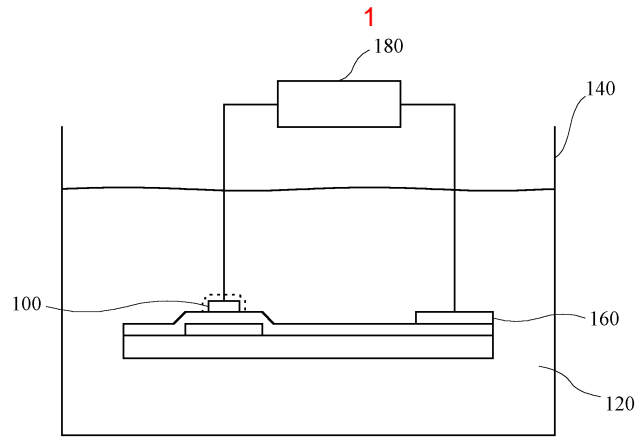
1

4.

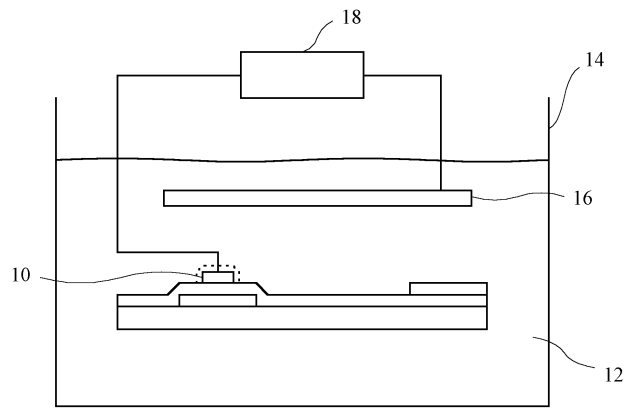
;

(bath) ;

;



3



专利名称(译)	制造薄膜晶体管液晶显示器件的方法和用于其的电沉积设备		
公开(公告)号	KR100366082B1	公开(公告)日	2002-12-26
申请号	KR1020000022760	申请日	2000-04-28
申请(专利权)人(译)	三星SD眼有限公司		
当前申请(专利权)人(译)	三星SD眼有限公司		
[标]发明人	SO WOORYOUNG 소우영 KIM EUNGJIN 김응진		
发明人	소우영 김응진		
IPC分类号	G02F1/136		
代理人(译)	LEE, YOUNG PIL		
其他公开文献	KR1020010098097A		

摘要(译)

目的：公开了一种用于制造液晶显示装置的薄膜晶体管方法，该方法应用平面切换（面内切换）模式的驱动方法，并且可以均匀地形成用于LDD宽度控制的聚合物。此外，公开了用于其中的电沉积方法的设备。
配置：本发明涉及用于制造液晶显示器件的薄膜晶体管方法，包括在预定工艺中进行的聚合物电沉积工艺，并且在用于设备的共面上浸入栅电极和形成用于存储电容器的电极的基板。电沉积过程和电沉积聚合物到栅电极。并且，根据本发明的用于制造液晶显示装置的薄膜晶体管方法将一端与在聚合物电沉积工艺上形成的栅电极连接，在基板上形成聚合物，所提供的固定电源和另一个固定电源。端部连接到用于存储电容器的电极并且其前进。效果：由于在栅电极中形成均匀的聚合物并精确控制LDD宽度，因此漏电流被切断，器件特性得以改善。电沉积和LDD。

